Структурные особенности твердого галлия в микропористом стекле

© И.Г. Сорина, С. Тіеп*, Е.В. Чарная, Ю.А. Кумзеров**, Л.А. Смирнов

Научно-исследовательский институт физики Санкт-Петербургского государственного университета,

198904 Петродворец, Россия *Cheng Kung National University, 701 Tainan, Taiwan **Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021 Санкт-Петербург, Россия

(Поступила в Редакцию 23 января 1998 г.)

Представлены экспериментальные результаты исследований структурных особенностей галлия в пористом стекле с диаметром пор $d = 4 \,\mathrm{nm}$ методом Дебая–Шеррера. Обнаружены структуры галлия, отличные от известных объемных модификаций.

Пористые стекла, заполненные различными материалами, являются в настоящее время объектами повышенного интереса. Свойства веществ, находящихся в ограниченной геометрии, могут в значительной степени отличаться от свойств объемных образцов. Так при замерзании воды в пористом стекле образуется кубическая структура, отличная от обычной гексагональной объемной модификации, на что указывают нейтронные исследования в стекле с диаметром пор 5 nm [1]. Структура твердого дейтерия в пористых стеклах также отличается от объемной [2]. В связи с вышесказанным исследование структуры галлия в пористом стекле представляет особый интерес, поскольку уже в объемном состоянии Ga обладает специфическими структурными свойствами. Известно, например, что объемный чистый галлий кристаллизуется в ряд модификаций, значительно отличающихся друг от друга [3].

Изучаемый образец был приготовлен из стекла, полученного путем термообработки натриево-боросиликатной системы с последующей кислотной проработкой [4]. Стекла тестировались методами ртутной порометрии и электронной микроскопии. Диаметр пор равнялся d = 4 nm, объем пор составил 0.15 cm³/g. Жидкий галлий вводился в пористые стекла под давлением 9 kbar. Степень заполнения объема пор составляла около 90%.

Исследования структурных особенностей твердого галлия в пористом стекле производились методом Дебая–Шеррера [5] в температурном интервале 4.5–300 К с использованием Си K_{α} -излучения. Результаты исследований схематично представлены на рис. 1–4. Как видно из полученных экспериментальных данных, в порах образуются три различные модификации твердого галлия. Структура, обозначенная цифрой *1*, образуется при охлаждении образца от комнатной температуры



Рис. 1. Дебаеграмма для галлия в пористом стекле с d = 4 nm: структура *I*, T = 250 K.



Рис. 2. Дебаеграмма для галлия в пористом стекле с *d* = 4 nm: структуры *1* и *2*, *T* = 150 K.



Рис. 3. Дебаеграмма для галлия в пористом стекле с *d* = 4 nm: структуры *1* и *3*, *T* = 200 K.



Рис. 4. Дебаеграмма для галлия в пористом стекле с *d* = 4 nm: структуры *1, 2* и *3, T* = 150 K.

до 250 К (рис. 1) и присутствует на всех без исключения дебаеграммах (отметим, что при комнатной температуре галлий в порах находится в жидком состоянии). При дальнейшем понижении температуры до 150 К наблюдается наложение на нее другой структуры, обозначенной цифрой 2 (рис. 2). После нагревания образца до T = 300 К и повторного охлаждения до 200 К на фоне структуры 1 появилась новая модификация (структура 3), отличная от первых двух (рис. 3). При новом понижении температуры до 150 К на дебаеграмме присутствовали все три структуры (рис. 4). При других

температурах наблюдались различные сочетания структуры *1* и двух других структур.

Нам удалось расшифровать структуру I, используя кривые Хэлла [5]. Она имеет тетрагональную объемно-центрированную решетку с постоянными a = b = 0.325 nm, c = 0.495 nm и отличается от известных модификаций объемного галлия. Следует отметить, что при давлениях выше 3.0 GPa образуется модификация объемного галлия, имеющая тетрагональную объемно-центрированную решетку с a = b = 0.2813 nm, c = 0.4458 nm [3]. Однако сильное различие в параметрах решетки не позволяет считать данные структуры одинаковыми.

Структура 2 содержит линии, принадлежащие α -модификации объемного галлия. Отсутствие ряда рефлексов α -Ga, возможно, связано с тем фактом, что объемный галлий имеет графитоподобную решетку [6], поэтому можно предположить, что в нем существуют атомные плоскости, связи между которыми несколько слабее, чем связи атомов в самой плоскости. Следовательно, в пористом стекле в принципе возможно относительное смещение этих плоскостей, что приводит к запрещению определенных отражений и сохранению других [7]. Таким образом, структура 2, возможно, представляет собой разупорядоченную α -модификацию, в которую кристаллизуется объемный галлий при нормальных условиях.

Структура 3 имеет более низкую симметрию, что значительно усложняет ее расшифровку. Однако можно сказать определенно, что соответствующие линии не соотносятся ни с одной из известных модификаций объемного галлия.

Таким образом, проведенные исследования твердого галлия в пористом стекле методом дифракции рентгеновских лучей указывают на возможность образования в пористом стекле структур галлия, отличных от объемных модификаций, и структуры, представляющей собой разупорядоченную α -модификацию объемного галлия.

Настоящая работа финансировалась РФФИ, грант № 96-02-19523 и NSC (Taiwan), грант 86-2112-М-006-012.

Список литературы

- M.-C. Bellissent-Funel, J. Lai, L. Bosio. J. Chem. Phys. 98, 5, 4246 (1993).
- [2] Y. Wang, W.M. Snow, P.E. Sokol. J. Low Temp. Phys. 101, 3, 929 (1995).
- [3] Химическая энциклопедия: в 5 т. / Гл. ред. И.Л. Кнунянц. Сов. энциклопедия, М. (1988). 623 с.
- [4] Двухфазные стекла: структура, свойства, применение / Отв. ред. Б.Г. Варшал. Наука, Л. (1991). 275 с.
- [5] Современная кристаллография / Под ред. Б.К. Вайнштейна и др. Наука, М. (1979). Т. 1. 383 с.
- [6] Г.Б. Бокий. Введение в кристаллохимию. Изд-во МГУ, М. (1954). 490 с.
- [7] B.E. Warren. X-ray Diffraction. Dover, N.Y. (1990).